**СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
по диссертации Трофимова Александра Александровича   
**«Технология разделения на кристаллы сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем на гетероструктурах AlGaN/GaN»**

Полное официальное наименование: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Сокращенные наименования:

1. Национальный исследовательский университет «МИЭТ»;

2. НИУ МИЭТ;

3. МИЭТ.

Фактический адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, дом 1.

Телефон: (499) 731-44-41.

Электронная почта: [netadm@miee.ru](mailto:netadm@miee.ru).

<https://www.miet.ru>

**Публикации в сфере исследований, которым посвящена диссертация**

1. Гребенкин В.З., Лавренов В.А., Самойликов В.К. «Напряженно-деформированное состояние держателя матриц оптико-электронного преобразователя при температурных воздействиях» // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Новые задачи технических наук и пути их решения», Челябинск, 2015, с. 70-75

2. Соловьев А.В. «Модернизация технологического маршрута производства КМОП КНС БИС с целью повышения пробивного напряжения транзисторов» // Потенциал современной науки, 2015, № 9, с. 20-23

3. Лазаренко П.И., Козюхин С.А., Шерченков А.А., Литвинов В.Г., Ермачихин А.В., Нгуен Х.Ф., Редичев Е.Н. «Электрофизические свойства аморфных тонких пленок GE2SB2TE5, легированных BI» // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, 2013, № 4-3 (46), с. 83-87

4. Соловьев А.В. «Модернизация технологического маршрута производства КМОП КНС БИС для повышения стойкости микросхем к радиационному воздействию с помощью средств приборно-технологического моделирования» // Новая наука: стратегии и векторы развития, 2015, № 1, с. 75-77

5. Лебедев С.В., Петросянц К.О., Попов Д.А., Самбурский Л.М., Стахин В.Г., Харитонов И.А. «Моделирование КНИ МОП-транзисторов для высокотемпературных КМОП интегральных схем (до 300°С) // сборник докладов Международной конференции «Микроэлектроника-2015. Интегральные схемы и микроэлектронные модули: проектирование, производство и применение», 2016, с. 470-474

6. Федотов С.Д., Емельянов А.В. «Анализ эпитаксиальных слоев кремния на сапфире, полученных различными методами» // тезисы доклада на 22 Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов, 2016, с. 171

7. Головинский М.С., Гундарцев М.А., Шалимов А.С. «Анализ различных компаундов для снижения температурного дрейфа датчика удара» // Молодежный научный форум: технические и математические науки, 2016, № 9 (38), с. 59-62

8. Тимошенков С.П., Симонов Б.М., Горошко В.Н. «Основы теории надежности» 1-е изд. // учебн. пособ., Изд-во Юрайт, — М.: 2016, 445 с.

9. Щагин А.В., Демкин В.И., Кононов В.Ю., Кабанова А.Б. «Основы автоматизации технологических процессов» 1-е изд. // учебн. пособ.,   
Изд-во Юрайт, — М.: 2015, 163 с.

10. Гаврилов С.А., Белов А.Н. «Электрохимические процессы в технологии микро- и наноэлектроники» 1-е изд. // учебн. пособ., Изд-во Юрайт, — М.: 2014, 258 с.

Ученый секретарь МИЭТ

к.т.н., профессор Н.М. Ларионов